

圖 3-21 平帶電壓  $V_{FB}$  對理想 n-MOS 之高頻 C-V 曲線的影響。

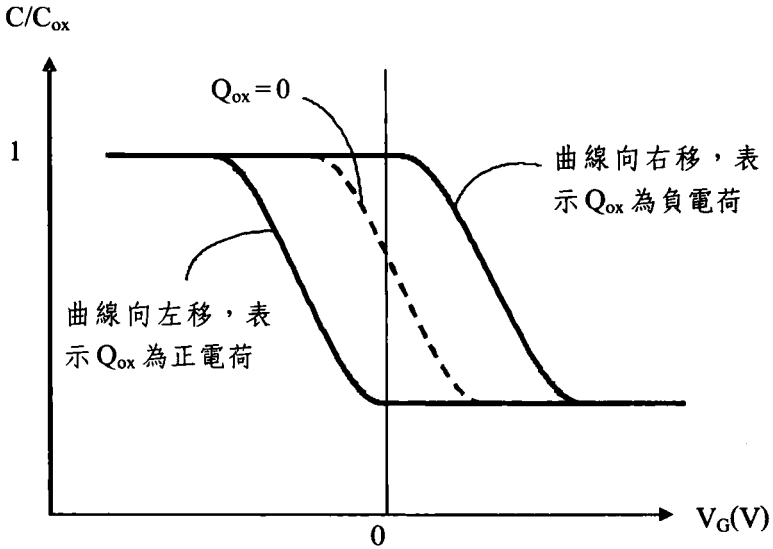


圖 3-22 氧化層電荷  $Q_{ox}$  使 n-MOS 之高頻 C-V 曲線產生偏移，且偏移量與  $Q_{ox}$  的絕對值成正比。

上述 C-V 特性曲線發生向左或向右偏移的觀念，在實務上有一個很重要的應用：決定等效氧化層電荷  $Q_{ox}$ 。對一個給定的 MOS 或 MOSFET 結構而言 ( $\phi_{ms}$